

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成31年1月10日(2019.1.10)

【公開番号】特開2018-78216(P2018-78216A)

【公開日】平成30年5月17日(2018.5.17)

【年通号数】公開・登録公報2018-018

【出願番号】特願2016-219845(P2016-219845)

【国際特許分類】

H 01 L 29/739 (2006.01)

H 01 L 29/78 (2006.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

H 01 L 29/06 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/78 6 5 5 B

H 01 L 29/78 6 5 3 A

H 01 L 29/78 6 5 8 H

H 01 L 29/78 6 5 2 P

H 01 L 29/06 3 0 1 G

H 01 L 29/06 3 0 1 F

H 01 L 29/06 3 0 1 V

H 01 L 29/78 6 5 5 C

H 01 L 29/78 6 5 5 F

H 01 L 29/78 6 5 2 G

【手続補正書】

【提出日】平成30年11月21日(2018.11.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項12

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項12】

第1導電型の半導体材料で形成されたドリフト層と、
前記ドリフト層の表面に設けられたセル部と、
前記ドリフト層の表面における前記セル部の周囲に設けられた外周部と、
前記ドリフト層の裏面に設けられ、前記第1導電型を有するバッファ層と、
前記バッファ層の裏面において前記セル部の直下領域および前記外周部の直下領域に渡
って設けられ、第2導電型を有し、前記外周部の直下領域における不純物濃度が前記セル
部の直下領域における不純物濃度よりも低いコレクタ層と、
を備える半導体装置。